

Germanium PNP Transistor


GC118

25V / 150mA

DATASHEET

OEM – RFT

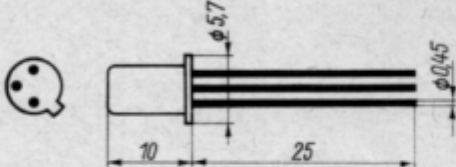
Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



GC 118

Rauscharmer Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 für Vor- und Treiberstufen in NF-Verstärkern.


C
B
E



Masse ca. 0,8 g


Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	-U _{CB0} = 25 V
Kollektor-Emitter-Spannung R _{BE} = 1 kΩ	-U _{CER} = 20 V
Kollektorstrom	-I _{CL} = 150 mA
Basisstrom	-I _{BL} = 50 mA
Sperrschichttemperatur	θ _{JL} = +80 °C
Umgebungstemperatur *	θ _{aL} = -25 °C bis +65 °C
Wärmewiderstand	R _{thja} = 0,38 grd/mW
Wärmewiderstand	R _{thjc} = 0,05 grd/mW




KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
 Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

8.69
31

GC 118					
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.	
Kollektor-Basis-Reststrom $-U_{CB} = 15\text{ V}$	$-I_{CBO}$		$9\ \mu\text{A}$	$18\ \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Reststrom $-U_{CER} = 20\text{ V}$ $R_{BE} = 1\ \text{k}\Omega$	$-I_{CER}$		$25\ \mu\text{A}$	$100\ \mu\text{A}$	
Emitter-Basis-Reststrom $-U_{(BR)EBO} = 10\text{ V}$	$-I_{EBO}$			$200\ \mu\text{A}$	
Dynamische Kennwerte				Stromverstärkungsgruppe	
Übergangsfrequenz $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $I_C = 2\ \text{mA}$	f_T		$1,2\ \text{MHz}$		
Kurzschlußstromverstärkung $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 2\ \text{mA}$ $f = 1\ \text{kHz}$	h_{21E}	45 71 112 ¹	90 140 224		C D E
Rauschmaß $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 0,3\ \text{mA}$ $R_g = 500\ \Omega$ $f = 1\ \text{kHz}$ $\Delta f = 1\ \text{kHz}$	F		5 dB		
Vierpolparameter $-U_{CE} = 6\text{ V}$ $-I_C = 2\ \text{mA}$ $f = 1\ \text{kHz}$	h_{11e}	$0,54\ \text{k}\Omega$	$2,1\ \text{k}\Omega$		C
	h_{11e}	$0,85\ \text{k}\Omega$	$3,3\ \text{k}\Omega$		D
	h_{11e}	$1,35\ \text{k}\Omega$	$5,3\ \text{k}\Omega$		E
	h_{12e}		$20 \cdot 10^{-6}$		
	h_{22e}		$200\ \mu\text{S}$		

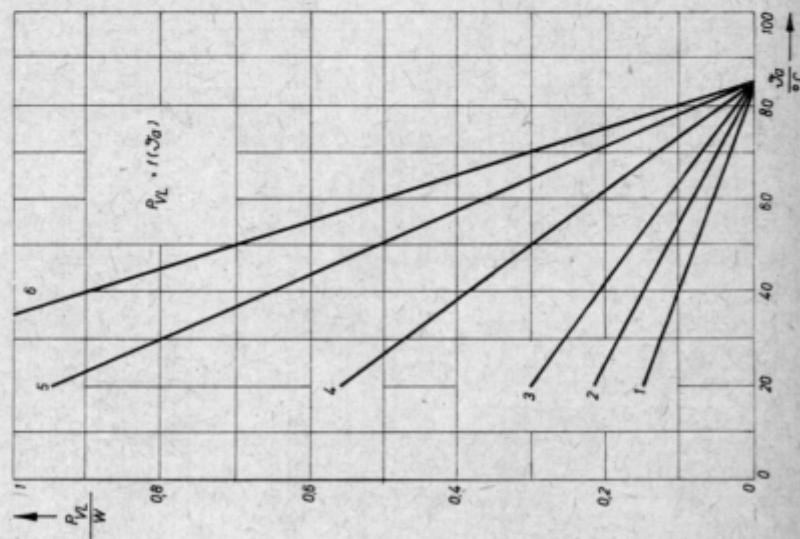
Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe D Transistor GC 118 D

8.69 **KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)** 
32 **Stammtrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)**



GC 116...GC 123

1. freitragend
2. mit Kühlstern $h = 9 \text{ mm}$, $d = 10 \text{ mm}$
3. mit Kühlfläche Al 2 stark vertikal montiert, unbearbeitet $A = 9 \text{ cm}^2$
4. Kühlfläche $A = 25 \text{ cm}^2$
5. Kühlfläche $A = 100 \text{ cm}^2$
6. mit angenähert idealer Kühlung



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stambetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

